

Simulation Numérique de l'amortissement Landau dans les plasmas

Yassine MOUFTAH
Guillaume ROUMAGE

2019

Dans tout le document, les problèmes seront étudiés sur un intervalle de temps noté $[0; T]$, avec $T \in]0; +\infty[$. Pour discrétiser le problème afin de faire des simulations numériques, on choisit un nombre de pas N . L'intervalle $[0; T]$ est subdivisé en N sous-intervalles. Le pas de temps, représenté par h , est alors donné par la formule : $h = \frac{T}{N}$.

1 Introduction

2 Plasma : définition, intérêts scientifiques et industriels

Il est courant de dire que la matière possède trois états : l'état solide, l'état liquide, ainsi que l'état gazeux. Mais en réalité, il existe un quatrième état de la matière : c'est le plasma.

Comme nous le savons, les atomes sont composés d'un noyau, contenant des protons et des neutrons, autour duquel gravitent des électrons. A l'état solide, liquide ou gazeux, les électrons qui orbitent autour des atomes restent sur leurs orbites. Lorsque de la matière est chauffée, elle passe successivement de l'état solide à l'état liquide, puis de l'état liquide à l'état gazeux. Lorsque le gaz est chauffé à très haute température (supérieure à 10^4 K), une partie de ce gaz devient un plasma.

Cette haute température libère les électrons des orbites de l'atome auquel ils étaient rattachés, qui peuvent désormais se déplacer dans le gaz. Celui-ci devient alors un mélange d'électrons et d'ions positifs.

L'analyse numérique permet de reproduire par le calcul une réalité physique. Cette simulation peut être effectuée pour plusieurs raisons : l'expérience peut-être irréalisable, avoir un coût trop élevé, ou encore pour prévoir grâce aux ordinateurs comment l'expérience va se dérouler, avant de faire cette même expérience en laboratoire, en conditions réelles.

L'analyse numérique permet aussi de vérifier l'exactitude des modèles théoriques sous-jacents, et dégager le modèle qui peut modéliser au mieux les phénomènes physiques observés. Le schéma numérique lui-même doit être bien adapté au modèle. C'est pour cela qu'il y a différents types de méthodes numériques.

3 Description des modèles théoriques utilisés

4 Description des méthodes numériques utilisés

5 Travail réalisé

Constantes

- Valeur d'une charge élémentaire : $e = 1.6021766208 \cdot 10^{-19} C$.
- Charge élémentaire d'un électron : $q_e = -e = -1.6021766208 \cdot 10^{-19} C$.
- Masse d'un électron : $m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} kg$.

Simulation de mouvements de particules en 1D

Nous simulons en premier lieu le mouvement d'une, puis de plusieurs particules en une dimension, c'est-à-dire sur un segment défini. Lors de la simulation, si la particule atteint le bord droit du segment, elle est envoyée sur le bord gauche, et inversement. Cela permet à la particule de rester dans l'intervalle d'espace étudié. Les particules étudiées seront les électrons. En effet, les mouvements des ions sont négligeables devant ceux des électrons. Nous considérerons donc les ions comme fixes.

Avec un champ électrique nul

Les équations donnant la position et la vitesse des électrons sont données par les systèmes suivants. Tout d'abord, en faisant l'hypothèse que le champ électrique auquel est soumis l'électron est nul.

$$\begin{cases} x'(t) &= v(t) \\ v'(t) &= 0 \end{cases}$$

avec $t \in [0; T]$.

En discrétisant et en utilisant la méthode d'Euler explicite, cela se réécrit :

$$\begin{cases} x_{n+1} &= x_n + h.v_n \\ v_{n+1} &= v_n \end{cases}$$

avec $n \in \{0, \dots, N-1\}$.

Avec un champs électrique stationnaire

Ajoutons maintenant un champ électrique stationnaire, c'est-à-dire qui ne dépend pas du temps. Les équations décrivant la position et la vitesse des électrons sont données par :

$$\begin{cases} x'(t) &= v(t) \\ v'(t) &= -\frac{q_e}{m_e}.E_0(x(t)) \end{cases}$$

avec $t \in [0; T]$, m_e la masse d'un électron, q_e la valeur de la charge élémentaire de l'électron, E_0 la fonction représentant la valeur du champ électrique en fonction de la position.

Dans la simulation, la fonction E_0 utilisée est $E_0 : x \mapsto \sin(\frac{\pi}{x.L}) \times \frac{-m_e}{q_e}$.

Justifier la multiplication par $\frac{-m_e}{q_e}$

Expression de v_{n+1}

Soit en discrétisant et en utilisant la méthode d'Euler explicite :

$$\begin{cases} x_{n+1} &= x_n + h.v_n \\ v_{n+1} &= v_n - h.\frac{q_e}{m_e}.E_0(x_n) \end{cases}$$

Nous pouvons aussi effectu  une discr tisation en utilisant la m thode d'Euler symplectique :

$$\begin{cases} x_{n+1} &= x_n + h.v_n \\ v_{n+1} &= v_n - h.\frac{q_e}{m_e}.E_0(x_{n+1}) \end{cases}$$

Trouver une bonne fonction pour E_0 pour faire une comparaison de l'espace des phases entre euler implicite et euler explicite

Avec un champs électrique discr t 

Dans les deux cas pr c dent, le champs  lectrique  tait donn  par une fonction. De ce fait, on pouvait savoir la valeur du champs  lectrique en n'importe quelle position.

Plus pr cis ment, il y a g n ralement deux champs  lectrique. Le champs  lectrique ext rieur, et celui cr   par les particules, qui est auto-consistant. Il se modifie donc   chaque pas de temps, en fonction du mouvement des  lectrons. De ce fait il faut le calculer   chaque pas de temps, et donc le discr t  . Cela implique que le champs  lectrique est une liste finie de valeurs.

Pour simplifier la mod lisation, nous consid rons qu'un seul et unique champs  lectrique agit.

Le calcul de la force  lectrique auquel est soumise un  lectron ce fait donc de la fa on suivante.

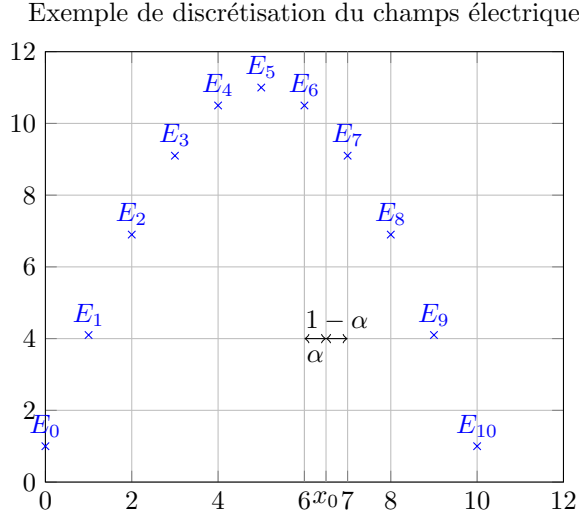
Notons E_{elec} la force  lectrique exerc e sur un  lectron. A un t instant, l' lectron se trouve   une position que nous noterons x_0 . Etant donn  que le champs  lectrique est une liste finie de valeurs, dans la majorit  des cas, nous ne connaissons pas la valeur du champs  lectrique au point x_0 .

On a $\lfloor x_0 \rfloor \leq x_0 < \lfloor x_0 \rfloor + 1$. Nous consid rons donc qu'un  lectron   la position x_0 est soumis aux champs  lectrique des points $\lfloor x_0 \rfloor$ et $\lfloor x_0 \rfloor + 1$, car nous connaissons la valeur du champs  lectrique en ces deux points. La derni re  tape consiste   pond rer le poids de chacun de ces deux champs  lectrique. Plus l' lectron est

proche de $\lfloor x_0 \rfloor$, plus le champs électrique en ce point a de l'influence. De même pour $\lfloor x_0 \rfloor + 1$. D'où au final, en prenant $\alpha = \lfloor x_0 \rfloor + 1 - x_0$:

$$E_{elec} = (1 - \alpha) \times E_{\lfloor x_0 \rfloor} + \alpha \times E_{\lfloor x_0 \rfloor + 1}$$

Le graphique ci-dessous représente un exemple de discrétisation du champs électrique.



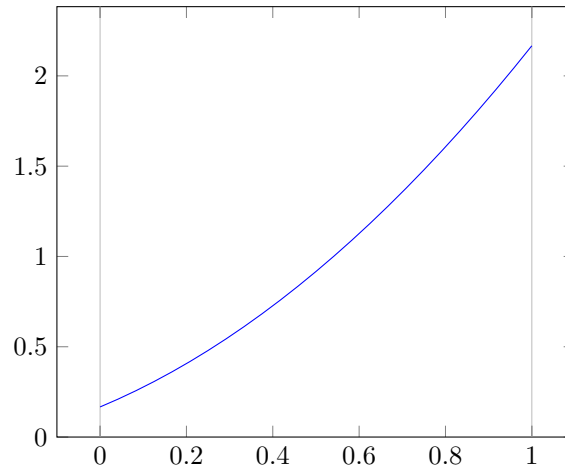
On observe qu'un électron à la position x_0 subira une force électrique $E_{elec} = (1 - \alpha) \times E_6 + \alpha \times E_7$.

Méthode d'acceptation-rejet

La méthode d'acceptation-rejet est une méthode permettant de simuler une loi de probabilité de densité f lorsqu'il est compliqué de simuler directement cette densité. Nous expliquons ci-après le fonctionnement de la méthode d'acceptation-rejet.

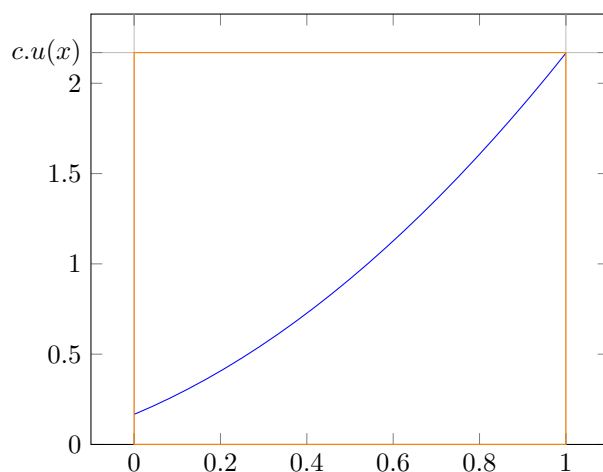
Considérons par exemple une variable aléatoire X dont la fonction de densité f_X est donnée par : $f_X(x) = (x^2 + x + \frac{1}{6}) \times \mathbf{1}_{[0;1]}(x)$.

Fonction de densité de $(x^2 + x + \frac{1}{6}) \times \mathbf{1}_{[0;1]}(x)$



Le support de la loi de X est finie, donc peut donc l'inscrire dans un rectangle. Ce rectangle correspond à la densité d'une loi uniforme u , augmenté d'un facteur c . Dans notre exemple, comme la f_X est définie sur $[0; 1]$, on a $c = f(1)$. De manière générale, si f_X est définie sur $[a; b]$, on a $c = \max_{x \in [a; b]} f_X(x)$.

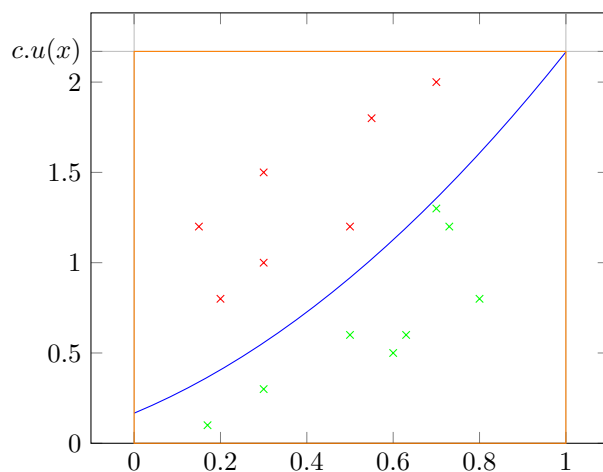
Fonction de densité de $(x^2 + x + \frac{1}{6}) \times \mathbf{1}_{[0;1]}(x)$ inscrite dans un rectangle



Cela fait, il faut générer des valeurs issues de la densité de u , et en accepter seulement une partie, de sorte que les valeurs retenus semblent provenir de la densité de X . On applique ensuite l'algorithme suivant :

1. On prend une valeur α sur $[0; 1]$, obtenue de la loi uniforme sur $[0; 1]$.
2. On prend une valeur β sur $[0; c.u(\alpha)]$ obtenue de la loi uniforme sur $[0; 1]$ et multiplié par le facteur c .
3. On positionne cette valeur sur le graphique de la densité de X . Si le point $(\alpha; \beta)$ se situe sous la courbe de f_X , c'est-à-dire si $\beta \leq f_X(\alpha)$, alors la valeur est acceptée. Sinon, elle est refusée.
4. Reprendre à l'étape 1 autant de fois que nécessaire pour avoir le nombre de points suffisant.

Représentation des points acceptés et rejetés en utilisant la méthode d'acceptation-rejet



La méthode d'acceptation-rejet peut-être utilisée pour simuler n'importe quelle variable aléatoire X de densité de probabilité f_X , tant que f_X peut-être borné par une autre densité g_Y à un facteur multiplicatif près, et que le support de f_X est finie.

6 Conclusion